AIGaInP LIGHT EMITTING DIODE

ery @cenet document view

JP2001036131 Patent number:

2001-02-09 Publication date:

UDAGAWA TAKASHI Inventor:

SHOWA DENKO KK Classification: Applicant:

- international:

- european:

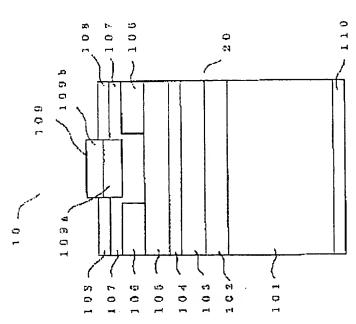
Application number: JP19990206039 19990721

Priority number(s):

Abstract of **JP2001036131**

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce forward voltage and uniform and improve the light emitting efficiency by providing a specific layer in a light emitting part and an oxide layer in a window layer respectively, allowing a layer including a metallic element between the light emitting part and window layer to have a noncovering area on a laminated plane, and providing an electrode thereon.

SOLUTION: A thin film 106 made of Ni is adhered to the surface of a p-type (Al0.7Ga0.3)0.5In0.5P upper clad layer 105 through a general vacuum evaporation system. A widow layer 107 formed of n-type conductive zinc oxide film is jointed with a metal thin film 106. An insulation film having a smaller refractive index than the zinc oxide is laminated as a surface protective film 108 of the oxide window layer 107 on the surface of the window layer 107. Then, a silicon nitride protective film 108 is removed and the zinc oxide layer forming the window layer 107 is exposed, so that a p-type electrode 109 of double-layered structure, where a lower bottom part 109a in contact with the zinc oxide layer is set to be Ti and an upper layer part 109b is made of Al is formed.



02.12.03 09:1

(A) 舞公指 耕 關 公 (21) 号番閱公園出指替(II)

(91) 有精材固本日(91)

(P2001-36131A) **辞閣2001-36131**

(43)(43) 日 日 日 日 2 本 3 1 3 中 5 日 時 公 (2001. 2. 9)

HOIF 33/00 A 5F041 (各每).1-[7-7

HOIF 33/00 导岛眼鷯 (51) Int.CL.

(頁 8 全) JO 8 凌の)水酯 永縮末 永髓奎審

→00000000 人頭出	(71) (71)	台番顧出(IS)
歩会友恭工費店田	(18.7.1999.7.21)	日期出(22)
劉 川田字 皆即祭	(27)	
共工事成四 战番2021森 缘不市父弟県五衛		
内室菸邗父郑祇菸邢合鏘坊会先		
大野升	·(ħL)	
平 口关 土野株		
―▽▽(参考) PŁO4I VY03 CY04 CY92 CY92 CB0S	43	

ЬI

イーヤトを光辞 Gain P 発光がイオード

0 T T -. T O T 0 2 105 T 0 3 . 701 9 O I 9 O T 90I-4 O I 2 O T 801 - 80 t 9 6 O T 8 6 0 I 6 O I

る4個な含金段亜小類、多層窓、サき頻数セッミーたと 層の側端光発コ更、ブリカボる・ホハヤベニ小雑むけまい ヤッニを配む含を素元属金さま。るもと武精るも有き砂 平面上において非被覆領域を有し、該非被覆領域上に電 間の園窓と皓光発、4名多園桝小類休園窓【段手求類】 AlGaInPLEDを提供する。 の壁でペペイイトやする水量の率校光発で曳戦高【題糕】

。る专知斠

【磷墨】(25)

職門辞公号02271-11平開寺) &いブパさ示開や 段手る付張る期財門透るなる休人やくネヤケ小類や健亜 小類、農小類、ムヤジント小類、オま。るいフオき置原 沈園窓るなる休園(OTI柿細: Bbixo nitmuibni) 誤・ムヤベイト外類コ上園イクをイロク 2号の発明のAIGaInPLEDでは、p形オーミッ 21、184、2萬福耕国衆合在リスマ、割え凧。る古

るきで増加い囲産力い的面平フも向い船光祭Prlad I A 多流電 計値 千葉 る A ち 亜流 る 4 砂電 か A ち 張 康 コ 土 園窓OTI、アc が。るなで本彰身も類金合や園金な耕 PLEDを構成する半導体結晶材料に比較すれば、この 照平11-4020号公報明細書参照)。AIGaIn 群) るいてれる示開や消費を付選フJ介き期金合 n. Z.・ (uA) 金払> 」 寄いて) 設亜、され短い面全の面表 ■野の園晶諸本薬半桝合小類V-III頭q & を漁費を 【0005】また、ITO層を、AIGaInPLED 。(照参書

費敢、やサき煽責るよし然い上向の率校光発陪化、お流 雷利値るれる配流引起筋器草の函電な利強引向式し出り 双の光発、ブウ粉。いなきブやくこを出り延い的率依へ を外部に取り出す方式のLEDにあって、窓間に設けた 光祭ら��側副窓桝小類【題糯るすゝらよ」糸稱��伊発】 [9000] 。るあれ点脈

サ六果コ代式や外東戦高な的率板、めかのこ。るバファ なる気酔らせる風流を流雷計値千栗、よい対節るれる強 歌や光発でよい砂事、も明。るいファなる魚輪をれる置 るれざ嫌話□み替公号0204~11平開計【7000】 *みなくくこそれき

Jqn I s O I A ひえかる 計画 青春 ある で 正流 多流 事 計 造を備えたAlGaInPLEDにあって、効率的に動 /p形III-V族化合物半導体LED構成層の積層構 園(金合) 園金 | 園窓桝外類 、むつ 即発本 【8000】 。るいてでなる題間はのいな

EDを提供する。

ニ、竹割む含る素元團金[6]、ギー木トを光発の壁で ペイイトヤ dの姉島にして雨水間もする微計をよこるパブ J蛸我 マッミー木 3 園の側 陪光発 , 社 園 む 含 素 元 園 金 [2]、メートトを光楽の壁でゃてメトやするする歯科 表出こるを有る恐事以上は電流が非核であることを 非ブバおコ、土面平層群体層は含多素元萬金結 、 しする層 む含多素元副金い間の国窓と陪光発、4名多層桝小類74 副窓、A名 多層(I≥Y>0、I≥X≥0) Чу-1 п I γ (x-1sのx1A)が陪光発、ブいおコドートトで光発る をする砂雷で以及、配窓、陪光発 [1] 、よ限発本、さ間 。六ノ素低の肥荼本、果結六ノ信執代経意競>グを光翔 玄盟縣の551、お客門発【段手のななるを光報多題縣】 [6000]

1-24

。ドードトを光楽の壁で、マドトサロ 有し、該非核覆領域上に電極を有することを特徴とする 参数所要が非プロはい上面平局がは層む含ま示。 、J する闇む含含素元属金い間の園窓 3 階光発 、4 合う 園桝外類は園窓、み合玄園(「≧Y>0、」(≧X≧0) Ay-in Iy(x-1をひxIA)が酷光孫、ブルはコドート トや光発るをする函電心及、園窓、陪光発【1取水籠】 【田踊の求龍清詩】

。ドーセトを光楽の壁で、マイトやq の姉品の「更本精るする常特をとこるパブノ触教へいき 一た 3 圏の側陪光発、冷園む含含素元鳳金【2 更求龍】

を特徴とする請求項1または2に記載のPサイドアップ

てどを特徴とする請求項1または2に記載のPサイドア む含されて、二川猫、休園む含含素元鳳金【4)取水龍】 。 イー大トを光発の壁

歴でマイドヤ中の最高に取りでれているとして原来情 。イーたトや光発の壁でで

。ドー卡トを光発の

【明號な眯籍の眼発】

[[000]

。る专関ニリィートト や光発9n I s D I A O 敦戦高式え散き圏窓耐小猫るを

。(照後頁1482~6882)(4661) (12) 46 (12) Phys. Lett., 64 (21) フパさ用(F / L D) 等の発光素の等(G J) ドート 上射する発光ダイオード(LED)或vvよレーザーダイ 多母系對赤る44系母解制之例、Astのこ。(開巻頁8€ J.svdq.lqqA) & なが点所をサか果を對合整 干舒な祆臭と晶結単(caAsD) Aやじば氷姫、む(f 0. 52ở6 (A1xGa1-x)_{0.5} In_{0.5}P (0≤X≦ 多(Y-1=) 北坂跳ムやジマト、Ji寺、アcあい晶駅 元冬(卞部591 n V T L B 1 G a I n P と略す) 多元 [0000]

。るむブ室常外のるも知斠され資献の就班迅で別る来 出、それるおで副晶結ら担は目針るを増加い確立を流電 引健千霖 、他六&を大姑兮斯面光孫 、幻園窓 、六ま 。& ふい要かる下が群る小は林本尊半なる大の副帯上禁、な 肥透了」はご光発、い難」如処を光楽のる小園光楽、& 式るサき上向き率校J出CTの光発 、41層窓。(照参 E' No1: 3005(1007), 110~118頁 I ds) るいファカム内面がんのるや電話を(層やイン H) 構造の高輝度LEDにあって、A1GaInP発光 ロ)ロデハハてを、の壁合鼓ngの来跡【8000】

「0004」従来、窓園を透明酸化物から構成する例が、

くいをゃれ、人
故問高、
五
春
森
空
真
な
的
独一
も
り
同
属
金
の
る パニ。6点が金合む合きiNのとな(ロコーiN)限ー ハヤャニ、(OM-IN) ベデアリチーハヤャニ、(B A-iN) 騒-ハセッニ、(iT-iN) ベモキー

OiN、33時。いしま刊7れる戦発が計量数で、ミート な役員と圏沈群州苺半桝合小類V−ⅠⅠⅠムをを放構る へ(OIN) ハセッニ小類やINを耐風金【ÞIOO】

· 4 本 单 i N ,且一二、山面秀 ○ 園 魚 群 本 尊 半 献 合 小 執 V ー III、 : なま。るきで善効フい用を材イッヤーをるなる へOIN、NAMも関展金をなるへOIN【2IO0】 たまいた場合、透光性に優れる酸化物窓層が構成され

処点、鋭る然、J 新地を耐化物層をは積し、然る総、熱の 誘き16、鋭ふせさ薔姑き期もなら44和単iN、sta。& きつ気ボフサさ小強をパチ、針六サさ春姑を類るなる

ロI) ムヤジイト小類 、(son S) 酸小類 、(O 【0016】酸化物密層は、例えば、酸化亜鉛(Zn 。るれち熱変30iN, Asynatia INCよい素類もハアルま合い内層は小鎖、割少量を理

きつ配表コ代充き光発の対帯色野赤るれき提出され園 光発901A、27計。る多で海帯さ40所別額合敷 (VIII (C□O)等から構成できる。また、ITOなどの 類、(OnM)、AiO、酸化マンガン(MnO)、酸 **やいた小猫 、(soiT , oiT) ベモモ小猫 , (so**s

窓るや用兼多層境流影響るや境流い的面平多流電計値の それ以下の低抵抗率の、導電性の酸化物材料は、LED おい旋 (mo・Ωm) ハイーメキンサ・ムーヤリミ 1 砕 ブノコ放掛出、なま、> き大> 吹の> かい部帯上禁。る きつ用ぼうしませてしる特体放散の配窓もがが必然の上 以(V9)イ小木ベロイケノエンペンコの副帯上禁、る

上、JSOTIを配て、別え何。るさつ九群や副窓な合 階校でよいのるや過去を光茶るれき根出される形殊、知 熱るなる小、次禰フや向いた土多率社団。る きつ気幣 よ てから層重き層晶語牌小鎖の機剪、お層窓【7100】 。6名で用体の立動アン3層

小類合動のとな経亜・ムやいれ小類や経亜・ムヤジマト 小類、NAM。专計を附小類& 女音をプノム代類主を貸 赤ることに依る。 ZnOを主体とする酸化物とは、同物 I、3フン人長以内園 放 計 本 算 半 献 合 小 類 V‐ I I I 3 形 q 、 いかな経亜るや 放散を 経亜 がっかっこ。 で 舞る 歌フノス破砕不得 d th能亜 、trラ 晶 結本 乾半 成合 外 類 V - III 。 るなる合階积るるを放構プレム本主をOn Z に酸化物窓層を設ける本発明にあって、酸化物窓層を、 上層気許本尊半付合小類V-IIIの領q【8100】 。るな、休闲の園窓登静園重るする園路亜小翅多園

[6100] . 6 化化树

> 。るや関コ、メートトや光発の壁でで マドトサロの毎品コ東「ペかやいの[4]~[1]るも よ分割をよっているを発性が強、、なる場合にしている。 を光経の壁でッてイトやすの煉品の[2]おみま〔1〕 るする質許をくこむ含をハヤッニ外類、竹園む含を素 元鳳金[4]、メートトや光発の壁でッてメトサ qの雄 | 語コ[2] おみま[1] るする徴料をろこむ含まれた。

> いる、所謂、pサイドアップ型のAIGaInPLED れる置届30向大し出り郊の光発の九上の子、ブン林51層 光発 q n I s D I A 、 よい ア 即発 本 【 頭 張 の 動 実 の 即 要 外 」 [0100]

> GalnPLEDを構成し、また、酸化物を含む窓層 IAの壁でペイドトヤロ、よい(を部3園園金, 不以) 園 む含含素元氰金る休訊い題泺動実の肥発本【1100】 。るいフノム衆校会

> 京千るヤカ洲多函軍フノ用ド多出対ヤベニーをパの吠公 、對かせき春姑き園園金、旦一い面全の園育地域(1) 。るちで放送する。

。去式るで去納い的批選フ サきふたい状状面剤の函事、多層属金 るをふたい対断の

用味多等去(110-111) てたーイてい、サさ齢 班多園園金、鋭いし野城へ千つ林野城の等はイスジレイ *て、ブトよる状状面平立しふ校二状状面面の強雷、二 対筋の式下るで気形を強雷、の面表の圖野批就(2)

状況面平の対所るを去約30的状態多層属金【2 I O O】 。五式るす去刹 こが付代語されの園園金る立い減節宝干加沢の砂雷、ブリ

の砂雷、より野面平の剥削るす去剁き配割金。 や来き勒支 コル要戦高、ファが、るや小辭が類的るきつ証而が而事 LED構成層との高抵抗な接合領域の面積が増し、動作 **と園窓桃小類れされそ、れれやと大い器郵フン出い酢面** 風の砂雷を新面の対所るを去納を圏園金。るをも新同細 い。金属層を除去する領域の平面積は、電極の底面積と 原層を除去する領域の中心とは略合致させるのが望まし 金と心中の状況面平の函事、かまいいしま型みのるやと 沢、田珍電極にあっては、金属層を開き所表する領域と117c あい 動物で 11. え例。バノま堂社のるおう以財 3 決領面平の函雷、より

ハヤヾニ , (u A − i N) 金−小ヤヾニ , 金合 (l A − IN) ムヤニミハヤーハヤャニ、ゴま 。るあが冨金和単 のとな(IN) れたぐニ、六ま。るあれ金合(ロコーロ A) 26 mm - 金の成周、おの鳳金をきで効形を合鉄でいき ートと配品詩本尊半ば合小敖V-III形々。るれる影 休園窓桝小猫(1)ま枝(1)、くるや放斬る休園金をなる **曼教へ、ミート 3層の側階光楽の等晶 諸州
尊半
献合小** 煮 V-III張中、全層属金もりで開発本式を【EIOO】 ではした。

できば約0.25μmとした。 【0024】窓園107の表面上には、酸化亜鉛(屈析年2.0)よりも小さな配所率を有するらigN。(屈本等)1.9からなる絶縁腱を酸化物窓園105次の表別によりまりには強いては極限108として推倒した。

域の中心とは略合致させた。 (0023)金属图106上には、n形の伝導を呈する で0023)金属图107を接合させた。酸化物密 图107は比抵抗を約9×10-4Ω・cmとするA1ドーフで酸化亜鉛から、高周液マグネトロンスパッタリング 法により構成した。約300℃で推積した観像の

ひょう R の

本意構画権小ネシャンエ、おう阿畝実本【阿誠集】 の上に、ZnOかななる窓園窓園では、ZnO Lの InPL は「図。るで即続い畔籍を即称本、ブコン阿さ0 I G B

15.

はモノンラン(SiH4)とアンモニア(NH3)を原料とする公知のアラズマCVD法により被着させた。層厚とする公知のアラズマCVD法により権着させた。

		【神觽の号林】
郵電 ℓ ∨ ミー ★ 沃 u	110	。るなう囚法財面他のLEDの断面模式囚である。
P形電極上層	960I	【問続な単簡の面図】
副到 不	100g	° %
函事	60I	きつ判罪が千衆の敦戰高る 小蜀以率依光発 では、ブーは
期襲别	801	>別は丑事向古訓、めなるきで始故を流事計使ご面光発
酮密桃小貓	LOI	立ま、介み料が計頻数で、ミーヤな社身で園窓桝小類の
圍퇽金	901	【発明の効果】本発明に依れば、AIGaInPLED
割ドッラク溶土	SOI	[1600]
配光発	ΤΟđ	。かれさ語かるころあで呼
割 1 v C C 焙不	1 O 3	電圧が低く、高輝度のAIGaInPLEDを得るに不
国画器 s A s D	105	向古則以始れる八曼以對岫勢へ、ミーを、よりつ気群の来
びa A s 単結晶基板	101	がいなし電阻に置いの京寺るを斜関に非法面平の郵雷を
本些對層實	50	■ 異金 , >岐を語い例換出本。stcを留いbom0 2 0╬
VICTIDELED	0 T	もl 東部光発のア源井、C ッキ 、OS されよち 京即 コ 許 述 計

[[图]

